

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年8月26日(2004.8.26)

【公開番号】特開2001-257374(P2001-257374A)

【公開日】平成13年9月21日(2001.9.21)

【出願番号】特願2000-114399(P2000-114399)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 31/04

// C 01 B 31/02

【F I】

H 01 L 31/04 H

H 01 L 31/04 E

C 01 B 31/02 101Z

【手続補正書】

【提出日】平成15年8月12日(2003.8.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面に電気絶縁層が形成されたカーボンフィルム基板と、前記電気絶縁層上に形成された下部電極層と、その下部電極層上に形成されたp型のCIS系の光吸收層と、その光吸收層上に形成されたn型半導体層と、そのn型半導体層上に形成された上部透明電極層とをそなえたことを特徴とする太陽電池。

【請求項2】

n型半導体層と上部透明電極層との間に、高抵抗層が設けられていることを特徴とする請求項1の記載による太陽電池。

【請求項3】

カーボンフィルム基板は、フィルム状に加工されたポリカルボジイミドを焼成することにより得られたものであることを特徴とする請求項1の記載による太陽電池。